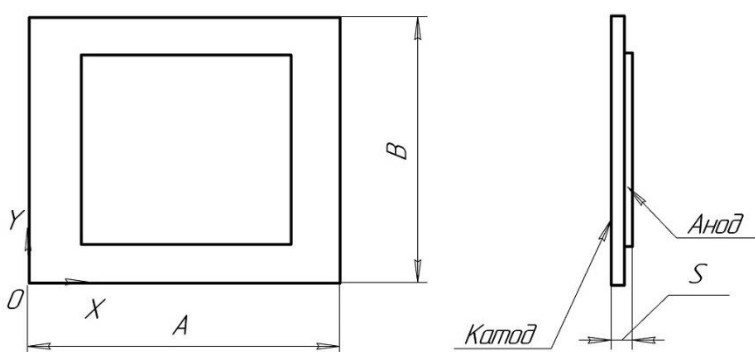



**Кристалл ультрабыстрого диода с мягкой характеристикой обратного восстановления  $U_{обр.} = 640В$** 

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое прямое падение напряжение
- Высокое быстродействие
- Малые значения обратных токов

**Габаритные размеры**


<b>A</b>	Размер кристалла, мм	2,05
<b>B</b>		2,05
<b>S</b>	Толщина кристалла, мм	0,25
Металлизация анода		Al-Ti
Металлизация катода		Ti-Ni-Ag
Пассивация		SiPoS, Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
Ширина линии скрайбирования, мм		0,06

**Общее описание**

Разрабатываемые кристаллы ультрабыстрых диодов предназначены для использования в выпрямителях высокой частоты, модуляторах, преобразователях, формирователях импульсов, ограничителях и других импульсных устройствах. Электрические характеристики подтверждаются тестированием 100 % кристаллов в нормальных условия ( $T_A=25^\circ C$ ) по основным параметрам :  $U_{обр.}$ ,  $I_{обр.}$ , а также выборочным тестированием кристаллов на каждой пластине по параметру  $U_{пр.}$  при номинальном значении прямого тока  $I_{пр.ср.}$ .

**Основные параметры и характеристики**

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.}$	-	640
Постоянный прямой ток, А	$I_{пр.}$	-	8
Максимальная температура перехода, °C	$T_{п. макс.}$	-	175
Время обратного восстановления, нс ( $I_{пр}=1A, V_{обр}=30B, dI_{пр}/dt=200A/мкс$ )	$T_{вос.обр}$	50	75


**Электрические параметры**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °С
		не менее	типовое	не более	
Средний прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А	$I_{пр.ср.}$		-	8	25±10
Постоянное прямое напряжение, В $I_{пр.ср.}=8$ А	$U_{пр.}$	1	-	1,2	
Постоянный обратный ток, мА ( $U_{обр.} = 640$ В)	$I_{обр.}$	-	-	0,01	
Постоянный обратный ток, мА ( $U_{обр.} = 640$ В)	$I_{обр.}$	-	0,25	0,5	125±10